

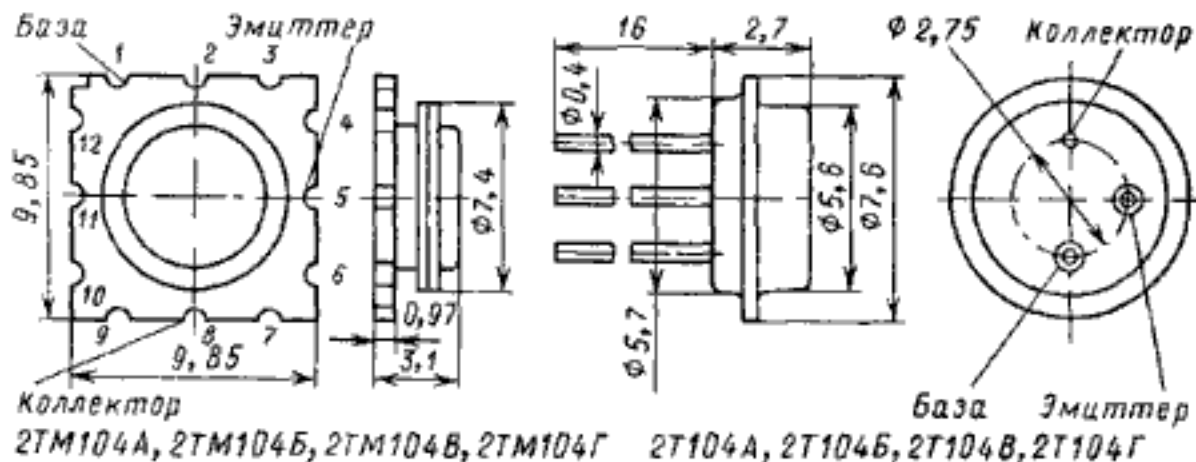
# 2ТМ104А, 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2ТМ104Г, 2Т104А, 2Т104Б, 2Т104В, 2Т104Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* мало-  
мощные

Предназначены для работы в усилительных и импульсных микро-  
модулях залитой и капсулированной конструкции

Выпускаются в металлостеклянном корпусе на керамической пла-  
те (2ТМ104А – 2ТМ104Г) и с гибкими выводами (2Т104А – 2Т104Г)  
Обозначение типа приводится в корпусе транзистора

Масса транзистора на керамической плате не более 0,8 г, с  
гибкими выводами не более 0,5 г



## Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме  
с общим эмиттером при  $U_{КБ} = 5$  В,  $I_3 = 1$  мА не  
менее . . . . . 5 МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим  
эмиттером при  $U_{КБ} = 1$  В,  $I_3 = 10$  мА

2ТМ104А, 2Т104А . . . . .	7–40
2ТМ104Б, 2Т104Б . . . . .	15–80
2ТМ104В, 2Т104В . . . . .	19–160
2ТМ104Г, 2Т104Г . . . . .	10–60

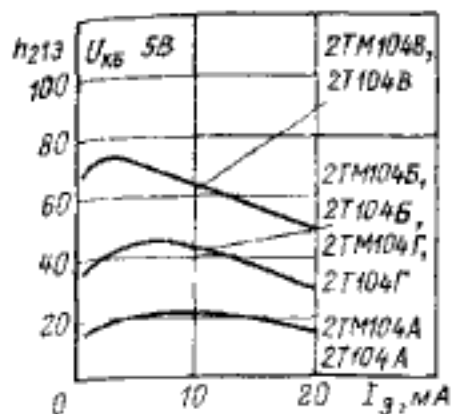
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мА не более	
при $I_B = 2$ мА 2ТМ104А, 2Т104А . . . . .	0,5 В
при $I_B = 1$ мА 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2ТМ104Г, 2Т104Б, 2Т104В, 2Т104Г . . . . .	0,5 В
Напряжение насыщения эмиттер-база при $I_K = 10$ мА не более	
при $I_B = 2$ мА 2ТМ104А, 2Т104А . . . . .	1 В
при $I_B = 1$ мА 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2ТМ104Г, 2Т104Б, 2Т104В 2Т104Г . . . . .	1 В
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В, $f = 3$ МГц не более . . . . .	50 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В, $f = 10$ МГц не более . . . . .	10 пФ
Обратный ток коллектора при $T = 213 - 298$ К не более	
при $U_{КБ} = 30$ В 2ТМ104А, 2ТМ104Г, 2Т104А, 2Т104Г	1 мкА
при $U_{КБ} = 15$ В 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2Т104Б, 2Т104В	1 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 10$ В, $T = 213 - 298$ К не более . . . . .	1 мкА

## Предельные эксплуатационные данные

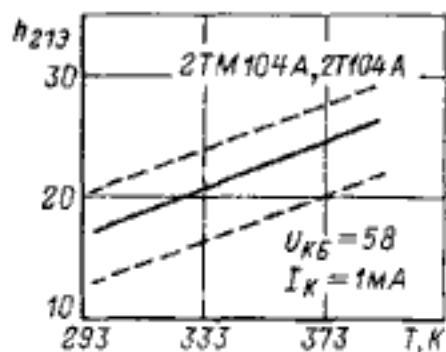
Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 10$ кОм или $U_{БЭ} = 0,5$ В	
при $T \leq 348$ К	
2ТМ104А, 2ТМ104Г, 2Т104А, 2Т104Г . . . . .	30 В
2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2Т104Б, 2Т104В . . . . .	15 В
при $T = 398$ К	
2ТМ104А, 2ТМ104Г, 2Т104А, 2Т104Г . . . . .	20 В
2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2Т104Б, 2Т104В . . . . .	10 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	
при $T \leq 348$ К . . . . .	10 В
при $T = 398$ К . . . . .	5 В
Постоянный ток коллектора	
при $T \leq 348$ К . . . . .	50 мА
при $T = 398$ К . . . . .	30 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	
при $T \leq 333$ К . . . . .	150 мВт
при $T = 398$ К . . . . .	41,6 мВт
Общее тепловое сопротивление . . . . .	0,6 К/мВт
Температура перехода . . . . .	423 К
Температура окружающей среды . . . . .	От 213 до 398 К

Примечание Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт, при  $T = 333 - 398$  К определяется по формуле

$$P_{K_{\max}} = (423 - T)/0,6$$

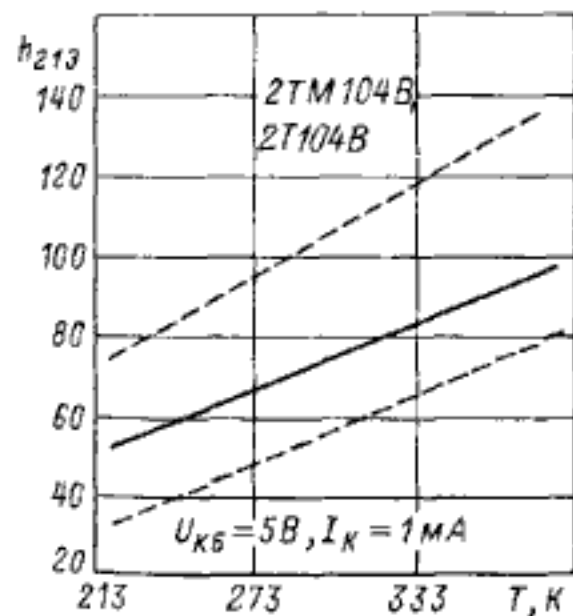
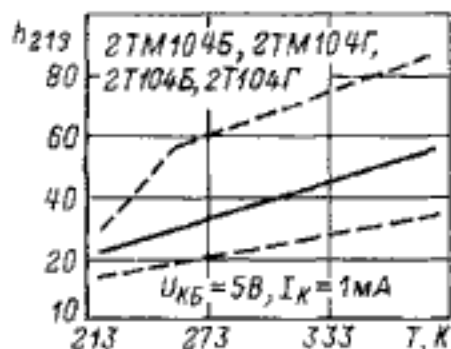


Зависимость коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от тока эмиттера

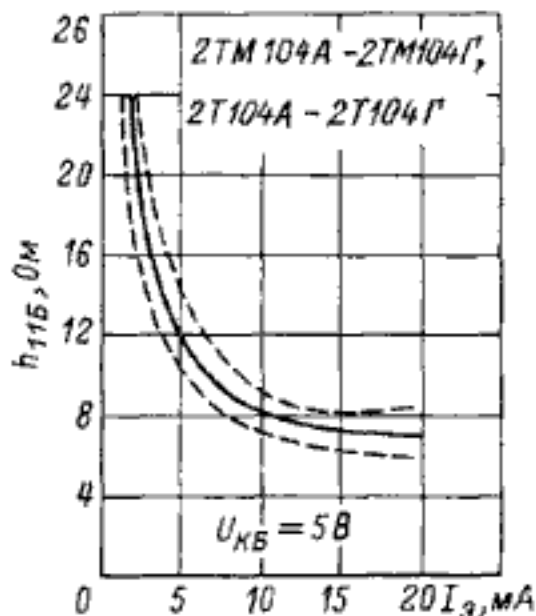


Зона возможных положений зависимости коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от температуры

Зона возможных положений зависимости коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от температуры



Зона возможных положений зависимости коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от температуры



Зона возможных положений зависимости входного сопротивления от тока эмиттера